

Содержание

• XX Международный симпозиум „Нанофизика и нано-электроника“, Нижний Новгород, 14–18 марта 2016 г.

Цырлин Г.Э., Штром И.В., Резник Р.Р., Самсоненко Ю.Б., Хребтов А.И., Буравлев А.Д., Сошников И.П.

Гибридные нитевидные нанокристаллы AlGaAs/GaAs/AlGaAs с квантовой точкой, полученные методом молекулярно-лучковой эпитаксии на поверхности кремния 1441

Балагула Р.М., Винниченко М.Я., Махов И.С., Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е.

Модуляция межподзонного поглощения света и межзонной фотолюминесценции в двойных квантовых ямах GaAs/AlGaAs в сильных продольных электрических полях 1445

Большаков А.С., Чалдышев В.В., Заварин Е.Е., Сахаров А.В., Лундин В.В., Цацульников А.Ф.

Оптическая спектроскопия резонансной брэгговской структуры с квантовыми ямами InGaN/GaN 1451

Яблонский А.Н., Морозов С.В., Гапонова Д.М., Алешкин В.Я., Шенгуров В.Г., Звонков Б.Н., Вихрова О.В., Байдусь Н.В., Красильник З.Ф.

Стимулированное излучение в гетероструктурах с двойными квантовыми ямами InGaAs/GaAsSb/GaAs, выращенных на подложках GaAs и Ge/Si(001) 1455

Данильцев В.М., Демидов Е.В., Дроздов М.Н., Дроздов Ю.Н., Краев С.А., Суругина Е.А., Шашкин В.И., Юнин П.А.

Сильно легированные слои GaAs:Te, полученные в процессе МОГФЭ с использованием диизопропилтеллурида в качестве источника 1459

Дорохин М.В., Павлов Д.А., Бобров А.И., Данилов Ю.А., Лесников В.П., Звонков Б.Н., Здоровейщев А.В., Кудрин А.В., Демина П.Б., Усов Ю.В., Николичев Д.Е., Крюков Р.Н., Зубков С.Ю.

Формирование контактов MnGa/GaAs для применений в оптоэлектронике и спинтронике 1463

Дубинов А.А.

Лазер на основе германия с гибридной поверхностной плазменной модой 1469

Ерофеева И.В., Дорохин М.В., Лесников В.П., Здоровейщев А.В., Кудрин А.В., Павлов Д.А., Усов Ю.В.

Кристаллическая структура и термоэлектрические свойства тонких слоев MnSi₂ 1473

Жукавин Р.Х., Ковалевский К.А., Орлов М.Л., Цыпленков В.В., Hübers H.-W., Dessmann N., Козлов Д.В., Шагин В.Н.

Поглощение и излучение в терагерцовом диапазоне частот при фотоионизации акцепторов в одноосно-деформированном кремнии 1479

Иванов К.А., Гиршова Е.И., Калитеевский М.А., Clark S.J., Gallant A.J.

Ангармонические блоховские осцилляции электронов в электрически смещенных сверхрешетках 1484

Калентьева И.Л., Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Звонков Б.Н., Кудрин А.В., Дроздов М.Н.

Влияние термического отжига на фотолюминесценцию структур с InGaAs/GaAs квантовыми ямами и низкотемпературным δ-легированным Mn слоем GaAs 1490

Шмагин В.Б., Вдовичев С.Н., Морозова Е.Е., Новиков А.В., Шалеев М.В., Шенгуров Д.В., Красильник З.Ф.

Электролюминесценция кремниевых МОП структур с массивами наноструктур Ge(Si) 1497

Климов А.Э., Эпов В.С.

Анизотропия магнитосмкости структур на основе пленок PbSnTe:In/BaF₂ 1501

Байдусь Н.В., Некоркин С.М., Колпаков Д.А., Ершов А.В., Алешкин В.Я., Дубинов А.А., Афоненко А.А.

Метод уменьшения ширины диаграммы направленности InGaAs/GaAs/AlGaAs многоямого гетеролазера 1509

Шамирзаев В.Т., Гайслер В.А., Шамирзаев Т.С.

Красная и дефектная люминесценция мощных InGaN/GaN ультрафиолетовых светоизлучающих диодов 1513

Косарев А.Н., Чалдышев В.В., Преображенский В.В., Путятю М.А., Семягин Б.Р.

Влияние слоя GaAs, выращенного при низкой температуре, на фотолюминесценцию квантовых точек InAs 1519

Кочерешко В.П., Авдошина Д.В., Savvidis P., Tsintzos S.I., Hatzopoulos Z., Kavokin A.V., Besombes L., Mariette H.

Конденсация экситонных поляритонов в микрорезонаторах, индуцированная магнитным полем 1527

Лобанов Д.Н., Новиков А.В., Юнин П.А., Скороходов Е.В., Шалеев М.В., Дроздов М.Н., Хрыкин О.И., Бузанов О.А., Аленков В.В., Фоломин П.И., Гриценко А.Б.

Эпитаксиальные слои GaN на подложках лангасита, полученные методом МПЭ с плазменной активацией азота 1532

Ляпилин И.И., Окороков М.С.

Динамическая генерация спин-волнового тока в гибридных структурах 1537

Можаров А.М., Кудряшов Д.А., Большаков А.Д., Цырлин Г.Э., Гудовских А.С., Мухин И.С.

Численное моделирование характеристик солнечных элементов на основе GaPNAs/Si гетероструктур и GaN нитевидных нанокристаллов 1543

Павельев Д.Г., Васильев А.П., Козлов В.А., Кошурин Ю.И., Оболенская Е.С., Оболенский С.В., Устинов В.М.

Моделирование транспорта электронов в малопериодных GaAs/AlAs сверхрешетках для терагерцового диапазона частот 1548

Бовкун Л.С., Криштопенко С.С., Иконников А.В., Алешкин В.Я., Кадыков А.М., Ruffepach S., Consejo C., Teppe F., Кнар W., Orlita M., Piot B., Potemski M., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Гавриленко В.И.

Магнитоспектроскопия двойных квантовых ям HgTe/CdHgTe 1554

Планкина С.М., Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Звонков Б.Н., Коннова Н.Ю., Нежданов А.В., Пашенькин И.Ю.

Исследование поперечного скола структур методом комбинационного рассеяния света 1561

Полищук О.В., Мельникова В.С., Попов В.В.

Широкоапертурное полное поглощение терагерцовой волны в нанопериодической плазмонной структуре на основе графена 1565

Мартовицкий В.П., Садофьев Ю.Г., Клековкин А.В., Сарайкин В.В., Васильевский И.С.

Исследование устойчивости метастабильных эпитаксиальных слоев GeSn к термическим воздействиям 1570

Байдусь Н.В., Кукушкин В.А., Звонков Б.Н., Некоркин С.М.

Наногетероструктуры с улучшенными параметрами для быстросветящихся и высокоэффективных плазмон-поляритонных светодиодов Шоттки 1576